

11/01/02
2002001469

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001年1月18日 (18.01.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/04049 A1

- (51) 国際特許分類: C01B 33/12, H01L 21/312, 21/90, C09D 183/16, 133/00 Tomoko) [JP/JP]. 清水泰雄 (SHIMIZU, Yasuo) [JP/JP]; 〒356-8505 埼玉県入間郡大井町西鶴ヶ岡1丁目3番1号 東燃株式会社 総合研究所内 Saitama (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/04021
- (22) 国際出願日: 2000年6月20日 (20.06.2000) (74) 代理人: 石田 敬, 外 (ISHIDA, Takashi et al.); 〒105-8423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37 森ビル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.
- (30) 優先権データ: 特願平11/199282 1999年7月13日 (13.07.1999) JP (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東燃株式会社 (TONEN CORPORATION) [JP/JP]; 〒150-8411 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 Tokyo (JP). 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 青木倫子 (AOKI, 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



162162



ACTION

WO 01/04049 A1

(54) Title: LOW-PERMITTIVITY POROUS SILICEOUS FILM, SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING SUCH FILMS, AND COATING COMPOSITION FOR FORMING THE FILM

(54) 発明の名称: 低誘電率多孔質シリカ質膜、その膜の形成された半導体装置、及び、その膜を形成するためのコーティング組成物

(57) Abstract: A porous siliceous film having a relative permittivity of less than 2.5; semiconductor devices having such films; and a coating composition for forming the film. The coating composition comprises an aluminum-containing polysilazane, a polyacrylic or polymethacrylic ester, and an organic solvent, and the above low-permittivity porous siliceous film can be formed by applying the composition and firing the resulting coating. The above siliceous film acts as an interlayer dielectric film, when formed in a semiconductor device.

/続葉有/